

ТЕОРИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОСТОЯНИЯ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ  
ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ ПЕРВОГО РОДА  
ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

*В.Г.Брызгалар, А.Е.Боровик, В.А.Попов*

Как известно, в антиферромагнетиках с магнитной анизотропией типа легкая ось в достаточно сильном внешнем магнитном поле вектор антиферромагнетизма (АФ)  $\vec{L}$  меняет свое направление на  $90^\circ$ . Изменение направления  $\vec{L}$  в зависимости от свойств магнитной анизотропии может происходить либо путем постепенного поворота, либо скачком [1]. Последнее имеет место, по-видимому, в  $MnF_2$  [2]. Мы рассмотрим случай опрокидывания  $\vec{L}$ , который является фазовым переходом первого рода.

Если образец имеет эллипсоидальную форму, то соображения, аналогичные соображениям Ландау [3] при рассмотрении промежуточного состояния сверхпроводников первого рода, показывают, что тело должно разбиться на домены с фазами, в одной из которых вектор  $\vec{l}$  параллелен главной оси (фаза  $l_{||}$ ), а во второй — вектор  $\vec{l}$  перпендикулярен этой оси (фаза  $l_{\perp}$ ). Условием равновесия фаз является постоянство магнитного поля в образце, действующего на магнитные моменты подрешеток. Это поле мы обозначим следуя [1] через  $H_{\Pi}$ :

$$H_{\Pi} = \sqrt{(2\delta + \beta' - \beta + b\pi M_0)(\beta + \beta')}.$$

Расчет в рамках феноменологической теории АФ показывает, что наименьшей поверхностной энергией обладают плоские границы раздела между фазами, параллельные главной оси. Расположение границ фиксируется анизотропией в базисной плоскости. Поворот  $\vec{l}$  в границе, разделяющей фазы, определяется формулой

$$\cos 2\theta = -\operatorname{th} \frac{x}{x_0}, \quad x_0 = \sqrt{\frac{(a - a_{12})\delta}{\beta(\beta - \beta')}}. \quad (1)$$

где  $\theta$  — угол между  $\vec{l}$  и главной осью,  $x_0$  имеет смысл толщины границы раздела,  $\beta$  и  $\beta'$  постоянные анизотропии,  $a$  и  $a'$  постоянные неоднородного, а  $\delta$  однородного обменного взаимодействия.

В качестве энергии АФ мы приняли

$$W = \int \left\{ \frac{1}{2} a \left( \frac{\partial M_1}{\partial x_1} \frac{\partial M_1}{\partial x_1} + \frac{\partial M_2}{\partial x_1} \frac{\partial M_2}{\partial x_1} \right) + a_{12} \frac{\partial M_1}{\partial x_1} \frac{\partial M_2}{\partial x_1} + \delta M_1 M_2 + \frac{1}{2} \beta (M_{1z}^2 + M_{2z}^2) + \beta' M_{1z} M_{2z} - (M_1 + M_2, H_0) + \frac{\hbar^2}{8\pi} \right\} dr, \quad (2)$$

где  $M_{1,2}$  — магнитные моменты подрешеток ( $M_1 = M_2 = M_0$ ) и  $H_0$  — внешнее магнитное поле, которое было бы в програнстве в отсутствии тела.

Учитывая, что  $\delta = 1/2\chi_{\perp}$ ,  $\beta \sim \beta' \sim 1$ ,  $a \sim a_{12} \sim a^2/\chi_{\perp}$  ( $a$  — постоянная решетки и  $\chi_{\perp}$  — статическая магнитная восприимчивость в направлении перпендикулярном главной оси), получим  $x_0 \approx (a/\chi_{\perp})$ . Считая  $\chi_{\perp} = 10^3$  имеем  $x_0 = 10^5$  см.

Если  $H_0 < H_{\Pi}$ , то возможно существование границ, в которых вектор  $\vec{l}$  поворачивается на  $180^\circ$ . Этот поворот  $\vec{l}$  описывается формулой

$$\cos\theta = -\text{th} \frac{x}{x_1}, \quad x_1 = \sqrt{\frac{2M_0^2(a - a_{12})\delta}{H_{\parallel}^2 - H_0^2}}. \quad (3)$$

Энергия, приходящаяся на единицу поверхности границы раздела фаз  $\mathcal{Q}||$  и  $\mathcal{L}_{\perp}$ , равна

$$\sigma = M_0^2 \sqrt{(a - a_{12})\beta(\beta - \beta')\delta^{-1}} \sim M_0^2 \alpha. \quad (4)$$

Знание поверхностной энергии дает возможность оценить размеры доменов и их структуру. Рассмотрим для простоты плоскопараллельную пластинку, перпендикулярно поверхности которой ориентировано внешнее магнитное поле. Как показывают оценки, ввиду относительно малой величины поверхностной энергии, ветвление доменов у поверхности начинается с толщин пластинки, порядка нескольких атомных слоев. Поэтому мы сразу рассмотрим тот простейший случай ветвления доменов, когда у поверхности на каждый домен приходится  $n$  клиньев. С точностью до коэффициентов порядка единицы, энергия пластинки может быть представлена в виде

$$W' = \text{const} + \sigma \ell_1 \ell_2 \ell_3 d^{-1} + \sigma n \ell_2 d \frac{\ell_3}{d} + M H_{\parallel} \ell_2 \frac{d^2 \ell_3}{n d}, \quad (5)$$

где  $d$  — размеры повторяющихся доменов,  $\ell_1 < \ell_2 < \ell_3$  размеры пластинки. Учитывая, что  $M = \chi_{\perp} H_{\parallel}$  находим  $d$  и  $n$ , соответствующие минимуму  $W'$

$$n = \left( \frac{\ell_1 \chi_{\perp} H_{\parallel}^2}{\sigma} \right)^{1/3} \left( \frac{\ell_1}{\sigma} \right)^{1/3}, \quad d = \left( \frac{\sigma \ell_1^2}{\chi_{\perp} H_{\parallel}^2} \right)^{1/3}. \quad (6)$$

Приравняв нормальные составляющие индукции внутри и вне пластинки получим выражение для относительной доли  $\rho$  вещества в фазе  $\mathcal{L}_{\perp}$

$$\rho = \frac{H_0 - \mu_{\parallel} H_{\parallel}}{(\mu_{\perp} - \mu_{\parallel}) H_{\parallel}}, \quad (7)$$

где  $H_0$  — магнитное поле на большом расстоянии от пластинки,  $\mu_{\parallel}$  — магнитная проницаемость фазы  $\mathcal{L}||$  в направлении легкой оси. Мы видим, что домены существуют при  $\mu_{\parallel} H_{\parallel} \leq H_0 \leq \mu_{\perp} H_{\parallel}$ .

Приведем выражение для эффективной магнитной восприимчивости пластинки. Если среднюю намагниченность пластинки представить в виде  $M_{\text{ср}} = \chi_{\text{ср}} H_0$ , то  $\chi_{\text{ср}} = (\chi_{\parallel} / \mu_{\parallel})$  при  $H_0 \leq \mu_{\parallel} H_{\parallel}$ ;  $\chi_{\text{ср}} = 1/4\pi$  при  $\mu_{\parallel} H_{\parallel} \leq H_0 \leq \mu_{\perp} H_{\parallel}$ , и  $\chi_{\text{ср}} = (\chi_{\perp} / \mu_{\perp})$  при  $\mu_{\perp} H_{\parallel} < H_0$ .

Авторы благодарят А.И.Ахиезера, И.А.Ахиезера, А.С.Боровика-Романова и В.В.Еременко за обсуждение результатов.

Физико-технический институт  
низких температур  
Академии наук Украинской ССР

Харьковский  
государственный университет  
им. А.М.Горького

Поступила в редакцию  
28 апреля 1969 г.

### Литература

- [1] Е.А.Туров. Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. Изд. АН СССР, М., 1963.
- [2] J. S. Jacobs, J. Appl. Phys., 32, 61S.
- [3] Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М., 1959.

---

*Письма в ЖЭТФ, том 9, стр. 637-639*

*5 июня 1969 г.*

### О КВАДРУПОЛЬНЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ МАКСИМУМАХ В МЕССБАУЭРОВСКОМ РАССЕЯНИИ

19

*В.А.Беляков, Ю.М.Айвазян*

В настоящей работе показано, что при мессбауэровском рассеянии  $\gamma$ -квантов существуют чисто ядерные (квадрупольные) дифракционные максимумы, возникающие вследствие зависимости амплитуды резонансного рассеяния от градиента электрического поля (ГЭП) на рассеивающем ядре [1]. Их существование возможно, если в рассеивателе на мессбауэровские ядра, находящиеся в кристаллографически эквивалентных положениях, действуют ГЭП, отличающиеся ориентацией главных осей. В этом случае атомы мессбауэровского изотопа, находящиеся в кристаллографически эквивалентных положениях и тождественные в релеевском рассеянии, при резонансном рассеянии эффективно выступа-